



Si

Si 用途：用作半导体材料，大功率晶体管，整流器，太阳能电池等。

主要性能参数			
晶体结构	面心立方		
熔点 (°C)	1420		
密度	2.4 (g/cm ³)		
掺杂物质	不掺杂	掺 B	掺 P
类型	SI	P	N
电阻率	> 1000 Ωcm	10 ⁻³ ~100Ωcm	10 ⁻³ ~100Ωcm
EPD	≤100/cm ²	≤100/cm ²	≤100/cm ²
氧含量 (cm3)	≤1~1.8×10 ¹⁸	≤1~1.8×10 ¹⁸	≤1~1.8×10 ¹⁸
碳含量 (cm3)	≤5×10 ¹⁶	≤5×10 ¹⁶	≤5×10 ¹⁶
尺寸	10×3m、10×5m、10×10mm、15×15mm、20×15mm 可按照客户需求，定制特殊方向和尺寸的基片		
厚度	0.5mm、1.0mm		
尺寸公差	<±0.1mm		
厚度公差	<±0.015mm 特殊要求可达到<±0.005mm)		
抛光	单面或双面		
晶面定向精度	±0.5°		
边缘定向精度	2° (特殊要求可达到 1°以内)		
取向	<100>、<110>、<111>等		
包装	100 级洁净袋，1000 级超净室		